



به نام ایزدوانا

(طرح درس الکترونیک ۱)

تاریخ به روز رسانی: ۹۷/۱۱/۲۳

دانشکده .. مهندسی برق و کامپیوتر.....

نیمسال دوم سال تحصیلی .. ۹۸-۹۷....

نام درس		فارسی: الکترونیک ۱		تعداد واحد: نظری ۳.. عملی...		مقطع: کارشناسی ■ کارشناسی ارشد □ دکتری □	
نام درس		لاتین: Electronic 1		پیش نیازها		مدارهای الکترونیکی ۱	
مدرس/مدرسین:		عبدالله عباسی		شماره تلفن اتاق:		۳۱۵۳۳۰۶۸	
پست الکترونیکی:		a_abbasi@semnan.ac.ir		منزلگاه اینترنتی:		http://aabbasi.profile.semnan.ac.ir	
برنامه تدریس در هفته و شماره کلاس:		شنبه ساعت ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۰۰ کلاس شماره ۱۱۱		سه شنبه ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۳۰ کلاس شماره ۱۱۴			
اهداف درس:		آشنایی با خواص فیزیکی، ساختار و مدلسازی عناصر نیمه هادی و کاربرد آنها در مدارهای ساده					
امکانات آموزشی مورد نیاز:							
نحوه ارزشیابی		فعالیت‌های کلاسی و آموزشی		ارزشیابی مستمر (کوئیز)		امتحان میان ترم	
درصد نمره		۵٪		۱۰٪		۲۰٪	
منابع و مآخذ درس		۱- غلامحسین روئین تن لاهیجی، "مبانی فیزیک و مدار الکترونیک"، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ۱۳۷۹ 2- B. Razavi, Fundamental of Microelectronics, John Wiley, 2008. 3- A. S. Sedra and K. C. Smith, Microelectronic Circuits, 6 th ed. , Oxford University Press, 2010 4- A. M. Sodagar, Analysis of Bipolar and CMOS Amplifiers, CRC Press, 2007. 5- R. C. Jaeger and T. N. Blalock, Microelectronic Circuit Design, 2 nd ed. , McGraw Hill, 2001.					

بودجه بندی درس

شماره هفته آموزشی	مبحث	توضیحات
۱	فیزیک نیمه هادی، نیمه هادیهای ذاتی و غیر ذاتی	
۲	محاسبه جریان در نیمه هادیها و پیوند PN	
۳	دیود و انواع آن	
۴	مدار معادل دیود	
۵	مدارهای دیودی	
۶	ترانزیستور دو قطبی BJT	
۷	بایاسینگ ترانزیستور دو قطبی BJT و انواع آن	
۸	پایداری حرارتی	
۹	رفتار و مدل سیگنال کوچک ترانزیستور دو قطبی BJT	
۱۰	تقویت کننده های پایه: ولتاژ، جریان، هدایت انتقالی، مقاومت انتقالی	

	تقویت کننده های تک طبقه BJT : امیتر مشترک، بیس مشترک و کلکتور مشترک	۱۱
	ترانزیستورهای MOSFET	۱۲
	بایاسینگ ترانزیستورهای MOSFET	۱۳
	رفتار و مدل سیگنال کوچک ترانزیستورهای MOSFET	۱۴
	تقویت کننده های تک طبقه MOSFET : سورس مشترک، گیت مشترک و درین مشترک	۱۵
	شبیه سازی با نرم افزار PSPICE	۱۶